

**Программа XI Международной конференции
«Аморфные и микрокристаллические полупроводники»**

19 ноября

Пленарное заседание

10:00 *Открытие конференции.*

Председатель оргкомитета **Е.И. Теруков**

10:15 *Коломийцевская лекция*

А.Г. Казанский

Особенности оптических и фотоэлектрических свойств металлоорганических перовскитов

11:00 **A.V. Kolobov**

Two-dimensional chalcogenide semiconductors and their heterostructures

11:30-11:45 кофе

11:45 **C. Koughia**

X-ray Induced Sm³⁺ to Sm²⁺ Conversion: Physics, Chemistry and Application to Microbeam Radiation Therapy

12:15 **С.А. Грудинкин**, А.Я. Виноградов, Н.А. Беседина, С.В. Коняхин,
М.К. Рабчинский, Е.Д. Эйдельман, В.Г. Голубев

Получение тонких графитоподобных плёнок методом магнетронного распыления: структурные, оптические и электрические свойства

12:45 **А. И. Попов**

Классификация полупроводниковых материалов по степени упорядочения их атомной структуры

13:20-14:30 обед

14:30 **С.В. Макаров**

Перовскитная нанофотоника

15:00 **Е.И. Теруков**

Аморфный гидрогенизированный кремний и солнечная энергетика в России

15:30 **С.О. Когновицкий**

Тонкопленочные солнечные модули на основе CuInSe

16:10-16:30 кофе

Секция А

Аморфный углерод, наноуглерод, графен и другие широкозонные материалы

- 16:30** Д.А. Курдюков, Д.А. Еуров, Д.А. Кириленко, М.К. Рабчинский, А.В. Швидченко, А.Я. Вуль, В.Г. Голубев
Изучение механизма агрегации и пептизации углеродных наноточек, синтезированных темплатным методом
- 16:50** **А.А. Хомич**
Эффект пространственного ограничения фононов в наноразмерных и в радиационно-поврежденных алмазах
- 17:10** В.П. Афанасьев, А.Д. Баринов, Ю.Н. Бодиско, А.С. Грязев, А.И. Попов, М.Ю. Пресняков, М.Л. Шупегин
Образование соединений металла в алмазоподобных кремний-углеродных плёнках
- 17:30** Ю. В. Ануфриев, Е. В. Зенова, А.М. Тагаченков, М. А. Тархов
Исследование фотопоглощающих свойств УНТ различной морфологии и оценка возможности их интеграции в существующие фотоэлектрические преобразователи
- 17:50** М.С. Молоденский, Г.Д. Дюдьбин, П.Е. Львов, А.А. Павлов, Р.М. Рязанов
Временная динамика процесса формирования наночастиц катализатора для синтеза углеродных нанотрубок

18:30 Welcome party

20 ноября

Секция В

**Аморфный, микрокристаллический, наноструктурированный кремний
и материалы на его основе**

- 10:00** О.М. Сресели, А.В. Белолипецкий, Д.А. Грачев, И.А. Карабанова,
А.В. Боряков, А.В. Ершов
Фоточувствительность слоев нанокристаллов SiGe в матрице SiO₂
- 10:20** А.В. Ершов, Я.Д. Кузякин, И.А. Карабанова, А.В. Нежданов, Н.В. Байдусь
Получение и свойства структур с массивами нанокристаллов кремния в
матрицах CeO₂ и SiO₂
- 10:40** В.А. Терехов, Е.И. Теруков, Ю.К. Ундалов, К.А. Барков, И.Ю. Поляков,
Д.А. Минаков, И.Е. Занин, О.В. Сербин, П.В. Середин
Перестройка оптических свойств пленок SiO_x при кристаллизации
нанокластеров кремния
- 11:00** **Ngo Ngoc Ha**
Defect driven photo-generated carrier relaxation in the binary alloys of Si-Ge
nanocrystals

11:20-11:40 кофе

Секция С

Халькогенидные и стеклообразные полупроводники

- 11:40** А.А. Шерченков, С.А. Козюхин, Н.И. Боргардт, П.И. Лазаренко, А.В. Бабич,
А.О. Якубов, Д.Ю. Терехов, Ю.С. Зыбина
Влияние метода осаждения на свойства тонких пленок материалов фазовой
памяти
- 12:00** С.А. Козюхин, П.И. Лазаренко, Ю.В. Воробьев, М.П. Смаев, А.А. Полохин,
Ю.С. Зыбина, В.Н. Сигаев
Лазерная модификация материалов фазовой памяти
- 12:20** П.И. Лазаренко, С.А. Козюхин, А.А. Шерченков, А.О. Якубов, М.Ю. Пресняков,
Е.П. Кириленко, Д.А. Дронова, М. Кузмичева, Ю.И. Чигиринский
Применение метода имплантации для управления свойствами тонких пленок
фазовой памяти
- 12:40** С.А. Дьяков, М.М. Воронов, С.А. Яковлев, I.A. Akimov, А.Б. Певцов,
С.Г. Тиходеев, Н.А. Гиппиус
Оптические свойства опаловых фотонных кристаллов, покрытых слоем
Ge₂Sb₂Te₅
- 13:00** Е.Ф. Троян, Б.С. Колосницын, В.Н. Данько
Эффекты памяти и переключения в тонкопленочных халькогенидных
соединениях GeTe/Sb₂Te₃

13:30- 14:30 Обед

- 14:30** А.М.Пашаев, **Б.Г. Тагиев**, О.Б.Тагиев
Эффект Пула-Френкеля в халькогенидных полупроводниках с различными кристаллическими структурами
- 14:50** **П.П. Серегин**, Е.И. Теруков, А.В. Марченко, А.Б. Жаркой, К.Б. Шахович
Антиструктурные дефекты в халькогенидных стеклах
- 15:10** **А.О. Якубов**, А.А. Шерченков, А.В. Бабич, П.И. Лазаренко, Д.Ю. Терехов
Изучение особенностей кинетики кристаллизации тонких пленок материалов фазовой памяти по результатам измерений температурных зависимостей удельного сопротивления
- 15:30** **К.Б. Алейникова**, Е.Н. Зинченко, А.А. Змейкин
Особенности атомного строения аморфных полупроводников и металлических стекол
- 15:50** К.N. Turmanova, **A.S. Zhakypov**, ZH.K. Tolepov, G.A. Ismailova, O.Yu. Prikhodko
Composition and structure of nano-scaled GST films, modified by silver impurity

16:10-16:30 кофе

Секция D

Органические полупроводники

- 16:30** **А.Р. Тамеев**, Г.Л. Русинов
Органические полупроводники для зарядо-транспортных слоев оптоэлектронных устройств
- 16:50** **А.Б. Никольская**, М.Ф. Вильданова, С.С. Козлов, О.И. Шевалеевский
Оптимизация структуры фотоэлектродов на основе диоксида титана для перовскитных солнечных элементов
- 17:10** **Д.В. Амасев**, С.А. Козюхин, В.Г. Михалевич, А.Г. Казанский
Влияние окружающей среды и длительного освещения на проводимость и фотопроводимость пленок металлоорганического перовскита $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$

СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

16:00 – 19:00

21 ноября

Секция Е
Технические приложения.
Структурные и электрофизические свойства.

10:00 А.В. Дроздовский, Г.А. Зарецкая, А.В. Кондрашов, М.И. Мартынов,
А.А. Никитин, К.О. Воропаев, А.С. Ионов, А.В. Петров, А.С. Абрамов, С.Н.
Аболмасов, Е.И. Теруков, Б.А. Калиникос
Исследование планарных волноведущих структур на основе нитрида кремния

10:20 Возняковский А.П., Неверовская А.Ю., Фурсей Г.Н., Возняковский А.А.
Двумерные углеродные структуры для низкопороговой полевой эмиссии

10:40 А.В. Бобыль, Е.И. Теруков
Опыт эксплуатации автономных солнечных станций и задачи повышения их
надежности

11:00 М.Ф. Вильданова, А.Б. Никольская, С.С. Козлов, О.К. Карягина,
О.И. Шевалеевский, О.В. Альмяшева, В.В. Гусаров
Перовскитные солнечные элементы с фотоэлектродами на основе
наноструктурированных слоев диоксида циркония

11:20-11:40 кофе

11:40 С.П. Вихров, Н.В. Рыбина, Н.В. Бодягин, С.М. Мурсалов, Н.Б. Рыбин
Исследование информационной емкости сложных неупорядоченных систем на
примере поверхности

12:00 В.Н. Вербицкий, И.А. Няпшаев, Е.И. Теруков,
А.С. Абрамов, А.В. Семенов, Г.Г. Шелопин, К.В. Емцев
Применение гетероструктурной технологии для изготовления
фотоэлектрических преобразователей на квази-монокристаллических
кремниевых подложках

12:20 И.М. Котина, О.И. Коньков, Е.Ф. Чмель, В.М. Базлов, Л.М. Тухконен,
С. Н. Аболмасов, Е.И. Теруков
Пролетные Si(Li) детекторы с p+-контактом из аморфного кремния

12:40 А.В. Медведев, А.А. Дукин, Н.А. Феоктистов, В.Г. Голубев
Сферический распределенный брэгговский отражатель на основе $\alpha\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x\text{:H}$ и $\alpha\text{-SiO}_2$ с полной фотонной запрещенной зоной

13:00 С.Е. Никитин, Бобыль А.В., Теруков Е.И., Трапезникова И.Н.

Текстурирование поверхности кремния с помощью окисления под тонким слоем V_2O_5 и согласование теплового расширения элементов конструкции высокоэффективных кремниевых солнечных фотопреобразователей

13:30-14:30 обед

**Секция F
Оксиды**

14:30 Паринова Е.В., Сиваков В., Чувенкова О.А., Коюда Д.А., Шлёйзенер А., Овсянников Р., Марченко Д., Пислярук А.К., Чумаков Р.Г., Турищев С.Ю. Электронное строение, фазовый состав и структура МОСVD покрытий нанонитевидного кремния оксидами олова

14:50 А.В. Белолипецкий, М.О. Нестоклон, И.Н. Ясиевич
Моделирование кремний-германиевых нанокристаллов в матрице SiO_2

15:10 Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, И.Н. Трапезникова
Характеристики ncl-Si и матрицы a- SiO_x , осажденных на катоде и вблизи анода магнетрона с помощью модулированной по времени DC-плазмы

15:30 А.Р.Семенов, Т.А. Холомина, В.Г. Литвинов, М.В. Голованова, А.В. Ермачихин
Моделирование электрофизических характеристик гетероструктур на основе оксида цинка

15:50 Д.А. Коюда, С.Ю. Турищев, В.А. Терехов, Е.В. Паринова, А.В. Ершов, Б.Л. Агапов, Т.В. Куликова, Е.Н. Зинченко, Р. Овсянников, Э.П. Домашевская
Особенности атомного и электронного строения светоизлучающих многослойных нанопериодических структур a-Si/ ZrO_2 и a- SiO_x / ZrO_2

16:30-16:40 кофе

СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

16:00 – 18:00

18:00

Круглый Стол

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СТЕНДОВЫЕ СЕКЦИИ

20 ноября, 16:00

Секция А

Аморфный углерод, наноуглерод, графен и другие широкозонные материалы

- A01.** И.Б. Захарова, В.Ф. Бородзюля, Н.М. Романов, Н.Т. Сударь
Обратимое переключения в низкоомное состояние в тонких пленках фуллерена C₆₀
- A02.** Е.Е. Ашкинази, А.А. Хомич, В.С. Седов, А.К. Мартьянов, М.В. Козлова, А.В. Хомич, М.А. Мытарев, Кошельков И.И., В.Г. Ральченко, В.И. Конов
Применение спектроскопии комбинационного рассеяния света для исследования структуры многослойных нанокристаллических алмазных покрытий
- A03.** В.В. Кононенко, А.А. Хомич, Р.А. Хмельницкий, В.М. Гололобов, М.С. Комленок, А.В. Хомич, А.Н. Деревяго, Н.А. Поклонский
Исследование аморфизации алмаза под воздействием интенсивного фемтосекундного лазерного излучения
- A04.** А.П. Рягузов, Р.Р. Немкаева, Н.Р. Гусейнов, А.Р. Асембаева
Зависимость оптической ширины запрещенной зоны в DLC a-C<Pdx> пленках от условий синтеза
- A05** Д.Н. Соколовский, П.С. Зеленовский, Я.Ю. Волкова
Исследование электрических и структурных свойств кристаллов фуллерена C₇₀ при давлениях до 45 ГПа
- A06.** А.А. Хомич, В.Г. Ральченко, В.С. Седов
Особенности двухфононного ИК поглощения в облученных реакторными нейтронами алмазах и в нанокристаллических алмазных пленках
- A07.** А.А. Хомич, А.А. Аверин, С.Н. Бокова-Сирош, А.Н. Деревяго, М.В. Козлова, Н.А. Поклонский, А.Ф. Попович, Р.А. Хмельницкий, А.В. Хомич
Дефектная структура алмазов, аморфизованных высокодозовым облучением реакторными нейтронами
- A08.** А.А. Бабаев, М.Е. Зобов, Д.Ю. Корнилов, С.В. Ткачев, Е.И. Теруков, В.С. Левицкий
Температурная зависимость электрического сопротивления оксида графена
- A09.** Т.К. Петросян, Суханова Г.В., Тебеньков А.В., Г.В. Тихомирова
Барические особенности проводимости и ТЭДС графита при комнатной температуре
- A10.** А.П. Рягузов, Р.Р. Немкаева, Н.Р. Гусейнов, А.Р. Асембаева
Перколяционная проводимость в DLC a-C<Pdx> пленках
- A11.** В.Вал. Соболев, В.В. Соболев
Оптические свойства и электронная структура кристалла 6Н - SiC

A12. Шевченко А.И., Карпенко Н.И., Гурченко В.С., Работягов К.В., Мазинов А.С.
Изменение проводящих свойств фуллеренсодержащих пленок в зависимости от концентрации фуллерена C₆₀

A13. Чекулаев М.С., Ястребов С.Г.
Наноразмерные кластеры на основе гибрида графена и даймондена, модифицированные металлами (Fe, Ni, Co)

Секция В

Аморфный, микрокристаллический, наноструктурированный кремний и материалы на его основе

- B01.** Л.В.Григорьев, Н.А. Быков, Я.Б. Егорова
Исследование фотолюминесценции и электрофизических свойств тонкопленочной структуры SiO₂-nano Si, легированной Er и Yb
- B02.** И.А. Курова, Н.Н. Ормонт
Фотоиндуцированные изменения фотопроводимости в нелегированных пленках аморфного гидрированного кремния при температурах выше комнатных
- B03.** М.П. Фараджева, А.В.Приходько, О.И.Коньков
Наноструктурированные материалы на основе YBa₂Cu₃O_{7-δ}
- B04.** А.В. Павликов, А.Г. Казанский, А.Н. Мацукатова, П.А. Форш
Влияние фемтосекундного лазерного облучения на концентрацию носителей заряда в легированном бором аморфном гидрогенизированном кремнии
- B05.** В.Вал. Соболев, В.В. Соболев
Оптические свойства и электронная структура кремния и силицида магния
- B06.** А.А. Ковалевский, А.С. Строгова, Я.С. Воронец, Д.Ф.Кузнецов
Изучение закономерностей формирования и распределения нанокластеров германия в твердых растворах Si-Ge
- B07.** А.А. Ковалевский, А.С. Строгова, Я.С. Воронец, Д.Ф. Кузнецов
Исследование формирования нанокластеров на аморфных поверхностях с различной энергией связи на межфазной границе
- B08.** В.Я. Когай, Г.М. Михеев
Топохимические реакции и фазовые превращения в наноразмерной двухслойной пленке Vi/Se
- B09.** Е.В. Абрашова, Е.В. Мараева, В.А. Мошников, Н.В. Пермяков, К.Н. Халугарова
Компьютерное моделирование процессов адсорбции инертных га-зов в полупроводниковых пористых матрицах для устройств опто-электроники
- B10.** Р.С. Смердов, А.С. Мустафаев, Ю.М. Спивак, В.А. Мошников
Композиционные наноструктуры на основе графена и пористого кремния для систем плазменной энергетики нового поколения

- В11.** Ю.М. Спивак, С.Г. Журавский, В.А. Мошников, А.О. Белорус, А.А. Паневин, К. Беспалова, П.А. Сомов, Л.В. Чистякова, Ю.М. Жуков, А.С. Комолов, Я.В. Букина, М.О. Портнова, Д. Башарова
Частицы пористого кремния как транспортные системы для ад-ресной доставки лекарств ко внутреннему уху

Секция С

Халькогенидные и стеклообразные полупроводники

- С01.** Нгуен Тхи Ханг, Козик В.В., Козюхин С.А.
Аморфные тонкие пленки As_2X_3 ($X=S, Se$), полученные методом спин-коатинга раствора
- С02.** А.М. Пашаев, Б.Г. Тагиев, О.Б. Тагиев, И.З. Садыхов, И.Т. Гусейнов, Р.А. Абдулхейов
Фотолуминесцентные свойства $BaGa_2Se_4$ легированный редкоземельными элементами (Ce, Eu)
- С03.** Пашаев А.М., Тагиев Б.Г., Тагиев О.Б., Набиева С.А., Алескеров Ф.К.
Формирование эшелонов и антиэшелонов на основе твердых растворов $Sb_2Te_3 - Bi_2Te_3$
- С04.** С.А. Яковлев, А.В. Анкудинов, Ю.В. Воробьев, М.М. Воронов, С.А. Козюхин, Б.Т. Мелех, А.Б. Певцов
Фазовые изменения и формирование периодических структур на поверхности пленок $Ge_2Sb_2Te_5$ при лазерном воздействии
- С05.** Ю.В. Воробьев, П.И. Лазаренко, С.А. Козюхин, Ю.С. Зыбина, А.О. Якубов
Моделирование изменения удельного сопротивления и коэффициента отражения тонкой пленки $Ge_2Sb_2Te_5$ при кристаллизации в условиях температурного отжига
- С06.** R. I. Alekberov, A. I. Isayev, S.I. Mekhtiyeva
The analysis of optical constants for $As_{40}Se_{60}$, $As_{40}Se_{30}Te_{30}$, $As_{40}Se_{30}S_{30}$ compositions
- С07.** Е.В. Школьников
Структурно-химические особенности полупроводниковых стекол систем $As_2Se_3-Sb_2Se_3$ и As_2Se_3-Sb
- С08.** С.А. Фефелов, Л.П. Казакова, Н.А. Богословский, К.Д. Цэндин, А.Б. Былев, С.Н.Гарибова
Температура шнура тока, возникающего при переключении в тонких слоях полупроводников системы Ge-Sb-Te
- С09.** М.М.Воронов
Анализ системы скоростных уравнений для изучения особенностей спектров ап-конверсионной фотолуминесценции редкоземельных ионов в халькогенидной матрице

- C10.** А.О. Дашдемиров, Дж.И. Гусейнов, О.М. Гасанов, Д.Ж. Аскеров
Компенсированные действия примеси празеодиума на проводимости твердых растворов на основе SnSe
- C11.** С.А. Козюхин, Н.А. Григорьева, И.И. Николаев, П.И. Лазаренко
Фазовый переход «аморфное-кристаллическое состояние» в тонких пленках GST225, исследованный методом синхротронной дифракции в геометрии скользящего отражения
- C12.** М.Е. Федянина, П.И. Лазаренко, Ю.В. Воробьев, А.А. Шерченков, С.А. Козюхин, А.В. Кукин, А.О. Якубов, Ю.С. Зыбина
Влияние кристаллизации на оптические свойства аморфных тонких пленок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$
- C13.** В.Б. Глухенькая, П.И. Лазаренко, С.А. Козюхин, Ю.В. Воробьев, А.А. Шерченков, М.С. Савельев, А.А. Полохин, А.Ю. Герасименко
Кристаллизация и аморфизация тонких пленок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ под воздействием нс-лазерного излучения
- C14.** М.В. Рыбин, А.Б. Певцов, С.В. Макаров, Д.А. Зуев, В.А. Миличко
Субмикронные сферические частицы GeSbTe , переключаемые световыми импульсами
- C15.** Н.В. Вишняков, А.Д. Маслов, П.С. Провоторов, Н.М. Толкач
Метод расчета комплексного показателя преломления тонких пленок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$
- C16.** Б. Н. Мирошников, И. Н. Мирошникова, А. Д. Баринов, М. Ю. Пресняков
Структура и электрофизические свойства фоточувствительных элементов на основе микрокристаллических халькогенидов свинца
- C17.** Б. Н. Мирошников, И. Н. Мирошникова, А. Д. Баринов
Кислород в микрокристаллических сульфидах свинца и кадмия
- C18.** Н.В. Мельникова, К.В. Курочка, Б.Н. Слаутин, Д.О. Аликин, К.С. Игнатова
Формирование фрактальных структур серебра на поверхности стеклообразных ионных проводников $\text{AgGe}_{1+x}\text{As}_{1-x}\text{S}_3$ и композитов на их основе, содержащих одностенные углеродные нанотрубки
- C19.** П.П. Серегин, Е.И. Теруков, А.В. Марченко, Н.Н. Жуков, К.Б. Шахович
Состояние примесных атомов ^{119}mSn в стеклообразных халькогенидах мышьяка в условиях радиоактивного равновесия изотопов $^{119}\text{mTe}/^{119}\text{Sb}$
- C20.** Н.М. Сергеева
Применение рамановской и поверхностно- усиленной рамановской спектроскопии в изучении плёнок люминофора
- C21.** А.И.Исаев, С.И. Мехтиева, Х.И.Мамедова, Р.И.Алекберов
Корреляция между структурой и физическими свойствами халькогенидной стеклообразной полупроводниковой системы As-Ge-Se
- C22.** С.Н.Гарибова, С.И. Мехтиева, А.И.Исаев, С.У.Атаева, Бабаев С.С

Исследование структуры пленок халькогенидной стеклообразной полупроводниковой системы Se-As- EuF₃ методом комбинационного рассеяния света

- C23.** Г.З.Багиева, Г.Д.Абдинова, Т.Д.Алиева, Н.М.Ахундова, Н.Б.Мустафаев, Д.Ш.Абдинов
Электрофизические свойства монокристаллов SnTe с различными концентрациями вакансий в подрешетке олова
- C24.** Е.В. Александрович, Г.М. Михеев
Лазерно-индуцированные изменения оптических свойств стеклообразных плёнок Se
- C25.** А.В. Тебеньков, Г.В. Тихомирова
Электросопротивление системы Cd_{1-x}ZnxAs₂ при высоких давлениях
- C26.** Е.В. Мальчукова, И.Н. Трапезникова, Е.И. Теруков
Структура, свойства и технические приложения боросиликатных стекол
- C27.** Е.В. Мальчукова, И.Н. Трапезникова, Е.И. Теруков
Ап-конверсионная люминесценция боросиликатных стекол, легированных ионами Gd³⁺
- C28.** М.М.Воронов, А.В.Жерздев, С.Craig, D.H.Hewak, S.Kasap, С.Koughia, А.Б.Певцов, А.П.Скворцов
Спектры поглощения и люминесценции халькогенидных стекол GaLaS(O), активированных ионами Er³⁺
- C29.** А.Ш. Абдинов, Р.Ф. Бабаева
Инжекционно-рекомбинационные явления в слоистых халькогенидных полупроводниках со случайными макроскопическими дефектами
- C30.** Tran Van Quang
Effect of electronic thermal conductivity on thermoelectric performance of leadsubstituted bismuth telluride

Секция D

Органические полупроводники

- D01** В. А. Рыжов
Оптические свойства иономеров в дальнем ($\lambda > 20$ мкм) ИК-диапазоне
- D02.** Е.В. Кривоги́на, П.И. Лазаренко, А.А. Полохин, В.В. Козик, С. А. Козюхин
Исследование гибридного перовскита CH₃NH₃PbI₃ методом спек-троскопии комбинационного рассеяния света
- D03.** А.А. Бабаев, А.М. Алиев, М.Е. Зобов, Е.И. Теруков
Теплоемкость полимерного композита на основе углеродных многостенных нанотрубок
- D04.** N.M. Romanov, S.F. Musikhin

Luminescence of MEH-PPV conjugating polymer and PbS quantum dots nanocomposite exposed to γ -radiation

D05. Д.В. Амасев, С.А. Козюхин, А.Г. Казанский
Особенности фотопроводимости и фотоиндуцированных состояний в пленках перовскита $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$

D06. А.А. Кононов, Р.А. Кастро
Модели переноса заряда в полимерных композитах на основе полифениленоксида с фуллереном и эндофуллереном в качестве наполнителя

21 ноября, 16:00

Секция Е
Технические приложения.
Структурные и электрофизические свойства.

E01. А.Р. Юсупов, Р.М. Гадиев, А.Н. Лачинов
Влияние фотовозбуждения на электропроводность границы раздела ПДФ/ПДФ

E 02. Е.Е. Ашкинази, В.С. Седов, А.А. Хомич, А.В. Хомич, Р.А. Хмельницкий, А.П. Большаков, Мытарев М.А., Кошельков И.И., В.Г. Ральченко, В.И. Конов
Изготовление и механические свойства резцов с нано- и микрокристаллическим алмазным покрытием

E 03. Абрамов А.С., Емцев К.В., Титов А.С., Теруков Е.И.
Применение люминесцентных методов для исследования гетероструктурных солнечных элементов на основе кремния

E 04. А.В. Бабич, А.А. Шерченков, Ю.И. Штерн, М.С. Рогачев
Исследование термических и термоэлектрических свойств наноструктурированных среднетемпературных термоэлектрических материалов для применения в термоэлектрических генераторах

E 05. Е.В. Безуглая, А.Д. Маслов, В.О. Сазонов
Использование научной программы AFORS-HEТ для исследования квантовой эффективности и вольт-амперных характеристик гомо- и гетеропереходных солнечных элементов

E 06. О.И. Коньков, И.М. Котина, Е.А. Чмель
Энергетическая диаграмма для тонких слоев (на примере NiT)

E 07. Д.Ю. Терехов, Д.В. Пепеляев, А.О. Якубов
Температурные зависимости коэффициента термо-ЭДС и удельного сопротивления магнетронных тонких плёнок $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$ для применения в тонкоплёночных термоэлектрических генераторах

E 08. А.В. Семенов, Д.А. Андроников, А.С. Абрамов, Е.И. Теруков
Особенности применения ТМБ и $\text{В}_2\text{Н}_6$ при формировании гетеро-перехода ФЭП на основе Si в конфигурации тыльный эмиттер

- E 09.** А.Д. Маслов, Е.В. Безуглая, Н.В. Вишняков
Методика расчета области с наибольшей скоростью рекомбинации носителей заряда в гетеропереходных кремниевых солнечных элементах с учетом слоя аморфного гидрогенизированного кремния
- E 10.** С.Н. Аболмасов, А.А. Абрамов, А.В. Семенов, Е.И. Теруков
Применение ИК-спектроскопии для контроля пассивирующего слоя гетероструктурных ФЭП на основе кремния
- E 11.** В.Н. Вербицкий, И.А. Няпшаев, Е.И. Теруков, А.С. Абрамов, Г.Г. Шелопин, К.В. Емцев
Текстурирование квазимонокристаллических кремниевых пластин для фотоэлектрических преобразователей
- E 12.** Н.В. Мухин, Г.А. Коноплев, К.В. Кочунов, М.В. Руденко, Н.В. Гапоненко, П.А. Холов, С.М. Завадский, Д.А. Голосов, В.В. Колос
Исследование фотоэлектрических свойств тонкопленочных гетероструктур сегнетоэлектрик-полупроводник
- E 13.** К.П. Аймаганбетов, А.У. Алдияров, Е.И. Теруков, Н.Ж. Алмасов, Н.С. Токмолдин, С.Ж. Токмолдин
Разработка установки для проведения комплексных адмиттансных измерений при исследовании полупроводниковых структур
- E 14.** А.В. Бобыль, В.Г. Малышкин, Е.И. Теруков
Экономическая эффективность солнечных электростанций: роль деградации Li-ion накопителей
- E 15.** В.В. Трегулов, А.В. Ермачихин, В.Г. Литвинов
Особенности фотоэлектрических процессов в полупроводниковой структуре с антиотражающей пленкой пористого кремния и р-п-переходом
- E 16.** С.П. Вихров, Н.В. Вишняков, В.В. Гудзев, В.Г. Литвинов, В.Г. Мишустин
Перспективы комбинированного подхода к исследованию многослойных барьерных полупроводниковых микро- и наноструктур
- E 17.** Г.А. Зарецкая, М.И. Мартынов, А.В. Дроздовский
Определение свойств материалов оптических микроволноводов прямоугольного поперечного сечения
- E 18.** А.Кукин, С.Аболмасов, А.Абрамов, Е.Мальчукова, Е.Теруков
Исследование свойств нестехиометрического нитрида кремния обогащенного кремнием в зависимости от параметров процесса плазмохимического осаждения
- E19.** Д.Б. Матюшкин, В.А. Мошников
Технология и оборудование для получения коллоидных квантовых точек, плазмонных наночастиц и гибридных структур на их основе
- E20.** Vagif Nevruzoglu, Sidar Aktepe, Göktürk Öztürk, Derya bal Altuntaş, Murat Tomaki
The Growth of Silver Based Illuminated Layer for Solar Cells with Novel Method

- E21.** Н.В. Лушпа, И.А. Врублевский, Е.В. Чернякова, Е.Н. Муратова,
В.А. Мошников
Исследование тепловых потоков от линейного источника тепла в печатной плате
из алюминия с анодным оксидом алюминия

Секция F Оксиды

- F 01.** Я.Ю.Волкова, К.Р. Шерматов, Д.К. Кузнецов, Е.А.Киселев
Электрофизические свойства диоксида циркония при давлении до 50 ГПа
- F 02.** Парина Е.В., Коюда Д.А., Овсянников Р., Федотов А.К., Федотова Ю.А.,
Стрельцов Е.А., Турищев С.Ю.
Состав и электронное строение композитных наноструктур никель-пористый
оксид кремния на кремнии
- F 03.** Р.А. Писарев, П.Н. Крылов, Р.М. Закирова, И.В. Федотова
Получение пленок ZrO_2 реактивным магнетронным распылением на постоянном
токе с сопутствующей ионно-лучевой обработкой
- F 04.** В. А. Терехов, К. А. Барков, А. В. Коновалов, С. А. Ивков, Ю. Л. Фоменко,
О. Е. Локтионова, Д. Н. Нестеров, Э. П. Домашевская
Влияние содержания оксидных фаз на электрические свойства пленок SIPOS
- F 05.** И.А. Няпшаев, П.А. Ишмуратов, Д.А. Андроников, В.С. Левицкий,
Е.Е. Терукова, С.Н. Аболмасов, К.В. Емцев, А.С. Абрамов, Е.И. Теруков
Влияние стехиометрического состава пленок оксида индия-олова на параметры
гетероструктурных ФЭП на основе кремния
- F 06.** С.С. Налимова, А.А. Бобков, А.С. Варезников, Е.А. Левкевич,
Д.С. Мазинг, А.И. Максимов, А.А. Рябко, А.А. Семенова, В.В. Сысоев,
В.А. Мошников
Структурированные слои на основе наностержней ZnO для газовой сенсорики

Секция G Сопутствующие материалы

- G 01.** Д.А. Еуров, Е.Ю. Стовпяга, Д.А. Курдюков, Д.А. Кириленко, А.Н. Смирнов,
М.А. Яговкина, Е. V. Shornikova, D.R. Yakovlev, В.Г. Голубев
Структура и люминесцентные свойства $GaN:Eu^{3+}$, синтезированного в порах
монодисперсных сферических мезопористых частиц кремнезема
- G 02.** М.Д. Шарков, М.Е. Бойко, Л.Б. Карлина, А.М. Бойко, С.Г. Конников
Исследование сверхструктурных свойств в пористом сильно легированном
фосфиде индия
- G 03.** В.Т. Аванесян, И.В. Писковатскова
Структурные и оптические свойства монокристаллов силиката висмута $Bi_{12}SiO_{20}$

- G 04.** А. В. Приходько, О. И. Коньков
Особенности ВТСП в условиях компенсации магнитной компоненты электромагнитной волны
- G 05.** В.Вал. Соболев, В.В. Соболев
Оптические свойства и проблема инверсии зон серого олова
- G 06.** Х.А.Гасанов, Дж.И.Гусейнов, И.И.Аббасов, Д.Ж.Аскеров, Ф.И.Мамедов
Электрон-фононное рассеяние квантово-размерной пленки с гиперболическим потенциалом Пещля-Теллера
- G 07.** А.В. Ильинский, В.М. Капралова, Р.А. Кастро, Л.А. Набиуллина, И.О. Попова, В.М. Стожаров, Е.Б. Шадрин
Электронный парамагнитный резонанс кристаллов силиката висмута, легированных ионами железа
- G 08.** М.И. Даунов, А.М. Мусаев
Количественное описание электрических и магнитных свойств структурированного твердого тела методом эффективной среды
- G 09.** Сайпулаева Л.А., Алибеков А.Г., Гаджиалиев М.М.
Исследование кинетических коэффициентов в разбавленном магнитном полупроводнике $Zn_{0.9}Cd_{0.1}GeAs_2$ допированном марганцем.
- G 10** Ш.М. Алиев, М.Ш. Алиев, Ж.Г. Ибаев
Датчик магнитного поля на механоэлектрическом эффекте в полупроводниках
- G11.** М.В. Кузьмин, М.А. Митцев, А.М. Мухучев
Размерные зависимости адсорбционных свойств нанопленок иттербия, выращиваемых на поверхности кремния: система CO-Yb-Si(111)
- G12.** К.Я. Смирнов, В.В. Давыдов, В.Ю. Рудь
Формирование и применение фотокатода на основе гетероструктур InP/InGaAs